PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-182721

(43) Date of publication of application: 21.07.1995

(51)Int.CI.

G11B 11/10

G11B 33/14

(21)Application number: 05-347960

(71)Applicant: VICTOR CO OF JAPAN LTD

(22)Date of filing:

24.12.1993

(72)Inventor: UEKI YASUHIRO

AIZAWA TAKESHI

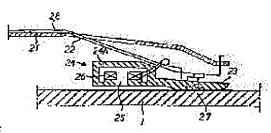
ITO YASUO

(54) MAGNETIC FIELD MODULATING HEAD OF MAGNETO-OPTICAL DISK AND METHOD FOR CONTROLLING TEMPERATURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a magnetic field modulating head and a method for controlling temperature capable of highly accurately leading the temperature of magneto-optical disk to a Curie point.

CONSTITUTION: The magnetic head is one, wherein a temperature sensor 27 is provided on a sliding section brought into contact with a disk surface or the one where a temperature detecting coil 29 for detecting the temperature of a magneto-optical disk 1 is wound on a core having a wound magnetic field generating coil 26. The temperature control method detects temperature by using the temperature sensor 27 before the sliding section 23 is brought into contact with the disk 1 and after a specified passage of time from when the disk I is brought into contact with this. Then, based on the obtained detected temperature, a temperature change in a recording layer corresponding to the passage of time is predicted and a laser beam power as heat adding means is controlled so as to cause a difference with a specified recording temperature close to 0 at least in an initial period when recording is started.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3365020

[Date of registration]

01.11.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

(19) 日本国特群庁 (JP)

€ 鞿 4 4年 噩 么 (12)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-182721

(43)公開日 平成7年(1995)7月21日

广内整理番号 **被刑犯**中 G11B 11/10

(51) Int CL.

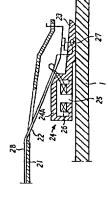
FI

586 B 8935-5D 33/14 審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 11 頁)

The second secon			
(21)出顯器号	特閣平5-347960	(71) 出職人 000004329	000004329
			日本ピクター株式会社
(22)出版日	平成5年(1993)12月24日		神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12智
			异
		(72)発明者	(72)発明者 植木 泰弘
			神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12都
			地 日本ピクター株式会社内
		(72) 発明者	相次 武
			神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3 丁目123
			地 日本ピクター株式会社内
		(72) 発明者	(72)発明者 伊藤 保男
			神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12科
			地 日本ピクター株式会社内
		(74)代理人	(74)代理人 弁理士 二瓶 正數

(54) 【発明の名称】 光磁気ディスクの磁界変響ヘッド及び光磁気ディスクの温度制御方法

【目的】 光磁気ディスクの温度を高精度でキュリー点 に到達させることのできる磁界変調ヘッド及び温度制御 方法を提供する。 【構成】 磁界変調ヘッドは、ディスク面に接触せしめ いは、磁界発生用コイル26が巻数されたコアに、光磁 気ディスク1の湿度を検出するための温度検出用コイル 29を巻装したものである。温度制御方法は、摺動部を ディスクに接触させるよりも前の時点と、ディスクに接 触させてから所定の時間を経過した時点とでそれぞれ湿 度センサ27を用いて湿度検出し、得られた検出温度に 少なくとも記録を開始した初期は、所定の記録温度との られる摺動部23に、湿度センサ27を備えるか、ある **偏差を零に近付けるように加熱手段のレーザビームパワ** 基づき経過時間に対応した記録層の温度変化を予測し、 ーを制御する。



(特許請求の範囲

【請求項1】 光磁気ディスクに磁界を与えるための磁 界発生部と、前記磁界発生部より前記光磁気ディスクの 方向に僅かに突出して前記光磁気ディスクのディスク面 に接触せしめられる褶動部と、前記光磁気ディスクの温 度を検出するために、前記摺動部の摺動面近傍に設けら れた温度センサとを有する光磁気ディスクの磁界変調へ [請求項2] 光磁気ディスクに磁界を与えるための磁 界発生用コイルを有する磁界発生部と、前記光磁気ディ スクのディスク面に接触せしめられ、前記磁界発生部と 一体的に形成された褶動部と、前記磁界発生用コイルが **巻装されているコアに巻装され、前記光磁気ディスクの** 温度を検出するための温度検出用コイルとを有する光磁 ベディスクの 段本 校置 ヘッド。

リー点付近まで到達させる加熱手段とを一体的に駆動し [請求項3] 着脱自在の光磁気ディスクを装着し、前 記光磁気ディスクを回転させた状態で、前記光磁気ディ と、レーザピームを照射して前記記録媒体の温度をキュ で情報を記録するに当たり、前記記録媒体の温度情報に 払びいた拒認加数手段のフーザアームパワーを制御する スクの記録媒体に変調磁界を印加する磁界変調ヘッド 光磁気ディスクの温度制御方法において、

前記磁界変調ヘッドとして、前記光磁気ディスクのディ クス面に接触せしめられる褶動部及びその褶動面近傍で 温度検出を行う温度検出手段を含むものを用い、

検出し、得られた検出温度に基づき経過時間に対応した 前記摺動部を前記光磁気ディスクに接触させるときより 前の時点と、前記摺動部を前記光磁気ディスクに接触さ せてから所定の時間が経過した時点とでそれぞれ温度を 前記記録媒体の温度変化を予測し、 少なくとも記録を開始した初期は、所定の記録温度との 偏差を容に近付けるように前記加熱手段のレーザビーム

ことを特徴とする光磁気ディスクの温度制御方法。

リー点付近まで到達させる加熱手段とを一体的に駆動し で情報を記録するに当たり、前記記録媒体の温度情報に 【請求項4】 着脱自在の光磁気ディスクを装着し、前 記光磁気ディスクを回転させた状態で、前記光磁気ディ と、レーザビームを照射して前記記録媒体の温度をキュ 基ろいて前記加熱手段のレーザアームパワーを制御する スクの記録媒体に変調磁界を印加する磁界変調ヘッド 光磁気ディスクの湿度制御方法において、

9

前部磁界変體ヘッドとして、前部光磁気ディスクに磁界 を与えるための磁界発生用コイルを有し、この磁界発生 用のコイルを温度検出に兼用するか、又は、前記磁界発 生用コイルが巻装されるコアに湿度検出用のコイルが巻 装された磁界発生部と、前記光磁気ディスクのディスク 面に接触せしめられ、前記磁界発生部と一体的に形成さ れた褶動部とを有するものを用い、

特開平7-182721

ତ

出温度に基づき前記加熱手段のレーザビームパワーを制 流して前記光磁気ディスクの温度を検出し、得られた検 前記摺動部を前記光磁気ディスクに接触させ、前記磁界 発生用コイル又は前記温度検出用コイルにテスト電流を

ことを特徴とする光磁気ディスクの温度制御方法。 [発明の詳細な説明]

に、光磁気ディスク(以下、単にディスクとも言う)に 対する情報記録時に変調磁界を印加する磁界変調ヘッド 【産業上の利用分野】本発明は、光磁気効果を用いて情 報を記録、再生する光学式情報記録再生装置に係り、特 に関すると共に光磁気ディスクの記録層を安定的にキュ リー点に到達させる温度制御方法に関する。 2

[0002]

クは、その基板上に磁性薄膜が形成されており、この磁 レーザビーム照射部分に、情報信号に応じてデジタル的 に変調した磁界を印加して、情報に応じた磁化パターン 【従来の技術】ミニディスク (MD) 等の光磁気ディス 性薄膜の磁化方向を変化させることによって情報が記録 される。この記録の方法の一つに、パイアス磁界を変調 して記録する方法がある。この方法は、レーザビームを リー点付近まで上昇させることにより保磁力が低下した 直流的に発光させて記録媒体に照射し、その湿度をキュ を形成するものである。 20

用いて再生(読出し)することができる。ところで、か れると、記録状態が良好にならないことがある。その対 [0003] このようにして記録された情報は、記録時 より低出力で直流的に発光させたレーザビームを記録媒 体に照射することによりその戻り光から磁気光学効果を かる情報の記録方法ではレーザアームを照射して記録媒 体を加熱しているため、レーザ光の田力が最適値からず **ナを配買し、いのカンサの田七に堪んにトワーヂアーム** 策として、磁界変調ヘッドの内部または近傍に温度セン のパワーを最適に制御することが提案されている。

ものである。このうち(4) に示したものでは、磁界発生 部の光磁気ディスク1に対向する側、すなわち、1対の 電磁石11を支持するヨーク12の下面に、断熱材13を介し ものでは、電磁石11を支持するヨーク12の隙間に、断熱 らに、(c) に示したものでは、コア15にコイル16を巻装 してオーバライト用磁気ヘッドを形成し、その側面に温 48号公報に示されたこの種の磁界変調ヘッドを示した て、温度センサ14が取り付けられており、(b) に示した **材13を介して、温度センサ14が取り付けられており、さ** [0004] 図11(a), (b), (c) は特開平3-1527 **質センサ14のリード線を接着したものである。**

ッドは、これに付替せしめた温度センサの出力に基づき **【発明が解決しようとする課題】上述した、磁界変調へ** ワーナアームのパワーを想御することによって光環気デ

20

イスクの湿度を安定的にキュリー点に到達させるように ドはいずれもディスク面とは空間で隔てられた位置に湿 ッジに収納されていたり、その回転中に温度検出をしな したものである。しかしながら、これのの磁界変調ヘッ 度センサが配置され、しかも、ディスク自体がカートリ ければならないことから、ディスクの温度よりも、むし ろ周囲温度を検出するものになっていた。

【0006】自動車用や携帯用の光学式情報記録再生装 下、昔込みとも言う)をするとき、装置自体は暖かいけ キュリー点に到達せず、うまく書込みができないことが 置においては、ディスクを挿入してその直後に記録 (以 れどもディスクは冷たいことがある。この場合、上述し ザビームのパワーを制御したのでは、ディスクの温度が て、これと同様な条件で書込みをした場合、データの書 込みはできても書込みレベルが低く、エラーレートが増 た磁界変調ヘッドの温度センサの検出値に基凸いてレー あった。また、データ用の光磁気記録再生装置におい 大することがあった。

【0007】本発明は上記の問題点を解決するためにな に、装置若しくは装置内温度とこれに挿入されるディス クの温度とが異なる場合でも、このディスクの温度を高 スクの磁界変調ヘッド及び温度制御方法を提供すること 精度でキュリー点に到達させることのできる光磁気ディ されたもので、ディスクの湿度を正確に検出すると共 を目的とする。

に接触せしめられる褶動部の褶動面近傍に、光磁気ディ クの方向に僅かに突出して光磁気ディスクのディスク面 発生用コイルが巻装されたコアに、光磁気ディスクの温 スクの磁界変調ヘッドは、磁界発生部より光磁気ディス められる摺動部と一体的に形成された磁界発生部の磁界 度を検出するための温度検出用コイルを巻抜したもので ある。また、本発明に係る光磁気ディスクの温度制御方 【課題を解決するための手段】本発明に係る光磁気ディ か、あるいは、光磁気ディスクのディスク面に接触せし スクの温度を制御するための温度センサを備えたもの [0008]

30

6 に接触させてから所定の時間が経過した時点とでそれぞ れ温度を検出し、得られた検出湿度に基づき経過時間に 対応した記録媒体の温度変化を予測し、少なくとも記録 る。さらに、本発明に係るもう一つの光磁気ディスクの 温度制御方法は、磁界発生用のコイル自体を温度検出に のコアに巻装するだけで済む温度検出用のコイルを有す る磁界発生部と、光磁気ディスクのディスク面に接触せ 法は、上述した摺動部の摺動面近傍に湿度センサを有す る磁界変調ヘッドを用い、褶動部を光磁気ディスクに接 を開始した初期は、所定の記録温度との偏差を零に近付 触させるときより前の時点と、摺動部を光磁気ディスク 兼用するか、又は、磁界発生用コイルの製造過程で同-けるように加熱手段のレーザビームのパワーを制御す

ディスクの温度を検出し、得られた検出温度に基づき加 イル又は温度検出用コイルにテスト電流を流して光磁気 ドを用い、この磁界変調ヘッドの褶動部を光磁気ディス クに接触させた状態で温度検出に兼用する磁界発生用コ 熱手段のレーザビームのパワーを制御する。

イスクのディスク面に褶動部が接触せしめられることを ワーの制御に利用することによってディスクの湿度を正 [作用] 本発明の磁界変調ヘッドにおいては、光磁気デ たので、装置若しくは装置内温度とこれに挿入されるテ イスクの温度とが異なる場合でも、このディスクの温度 を正確に検出することができ、これをレーザビームのバ 体的に形成された磁界発生部の温度を検出するようにし 利用して、この摺動部自体の温度またはこの摺動部と 確にキュリー点に到達させることができる。

装置若しくは装置内温度とこれに挿入されるディスクの リー点に到達させることができる。さらに、本発明に係 【0010】また、本発明の光磁気ディスクの温度制御 イスクに接触させてから所定の時間を経過した時点の各 湿度検出値に基づき、経過時間に対応した記録層の温度 方法においては、磁界変調ヘッドの褶動部を光磁気ディ スクに接触させるよりも前の時点と、摺動部を光磁気テ 変化を予測し、少なくとも記録を開始した初期は、所定 温度とが異なる場合でも、ディスクの温度を正確にキュ の記録温度との偏差を零に近付けるようにしているで、 るもう一つの光磁気ディスクの温度制御方法において

って検出できることに着目したもので、磁界変調ヘッド 磁気ディスクの温度を検出し、得られた検出温度に基づ は、磁界変調ヘッドの摺動部を光磁気ディスクに接触さ せたとき、磁界発生部の温度は光磁気ディスクの温度と 関係付けられ、かつ、磁界発生部の温度を磁界発生用コ イル又は温度検出用コイルにテスト電流を流すことによ の摺動部を光磁気ディスクに接触させた状態で磁界発生 用コイル又は温度検出用コイルにテスト信流を流して光 き加熱手段のレーザアームのパワーを制御することによ って、装置若しくは装置内湿度とこれに挿入されるディ スクの温度とが異なる場合でも、ディスクの温度を正確 にキュリー点に到途させることができる。

[0011]

は、摺動部23と磁界発生部24のフレーム24Aとを一体 **植例の構成を示す断面図である。図1において、ヘッド** アーム21はその基端部、すなわち、図示を省略した図面 細に説明する。図1は本発明の磁界変調ヘッドの第1実 の左端部が光学式情報記録再生装置のヘッド駆動部に結 化したものが接合されている。 植動部23は磁界発生部24 【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例によって詳 **合されている。このヘッドアーム21の中国部と先縊部と** の間にサスペンション22が、その先籍語の上下島可能に 支持されている。サスペンション21の先端部の下面に

ようにこれらの底面が二段になっている。このため、揺 動部23が光磁気ディスク1のディスク面に接触せしめら れたとき、磁界発生部24は一定の間隙を保ってディスク

また、磁界発生部24には、「E」型のコア25が装着され ル26が巻装されている。また、摺動部23の内部には、好 ましくは、接触面から0.5mの位置にサーミスタ又は ダイオードからなる温度センサ27が装着されている。サ cuit)からなる配線28が載置され、その先端部の引出し 1と対向することになり、これによって、ディスク面に ると共に、その中央脚に図示省略のポピンを介してコイ スペンション22の上屆に、FPC (Flexible Print Cir 印加される変調磁界の強度を一定にすることができる。 て、励磁電流の供給と、温度検出とを可能にしている。 線をコイル26及び温度センサ27に接続することによっ

1との接触面の近傍に温度センサ27が装着されているの で、この温度センサ27の褶動部23を光磁気ディスクに接 なお、温度センサ27を接触面に接近させすぎると、摺動 第23の題耗により温度センサ27が破壊される異れがある ため、図示のように接触面から0.5mの位置が好適で [0012] かかる構成の磁界変調ヘッドは、ディスク 触させ、かつ、光磁気ディスクの回転停止状値では、テ イスク1と殆ど差のない温度を検出することができる。

ピン (図示を省略)を用いて、ディスク1に近い側に磁 れぞれ装着されている。この場合、磁界発生用コイル26 【0013】 図2は本発明の磁界変調ヘッドの第2実施 例の構成を示す断面図である。図中、図1と同一の要素 には同一の符号を付してその説明を省略する。第2実施 例は、温度センサとして、コア25の中央脚に温度検出用 コイル29を巻装したものである。すなわち、コア25の中 央脚には、軸方向に二つの巻付け部を有する樹脂製のボ 界発生用コイル26が、その奥に温度検出用コイル29がそ のターン数は33で、抵抗値は5オームであり、温度検 出用コイル29のターン数は33で、抵抗値は50オーム (25℃) である。

を検出することができるが、ディスク1が回転すると陸 との接触面の近傍に温度センサ27があるため、その摺 スク1の停止状態では、ディスク1と殆ど差のない温度 この点、図2に示した磁界変調ヘッドは、光磁気ディス る。また、磁界発生用コイル26と同じコアに、温度検 出用のもう一つのコイル29を巻装するだけで済むこと から、サーミスタ又はダイオードを装着することに比べ 【0015】次に、図3は本発明の光磁気ディスクの温 【0014】図1に示した磁界変調ヘッドはディスク1 動部23を光磁気ディスクに接触させ、かつ、光磁気ディ ク1の停止状態での検出精度は若干劣るが、デイスク1 熔熱の影響を受けて検出精度の低下を余儀なくされる。 の回転による摩擦熱の影響を受け難いという利点があ て容易、かつ、安価に製作できるという利点もある。

特開平7-182721

€

を用いて説明したもので、情報の書込みに際して、その ある。ピックアップ装置3は、主に、レーザビームを収 束してその焦点を光磁気ディスク1のディスク面に合致 させる機能と、その反射光をセンサで検出し、得られた ング手段を付帯し、しかも、ピックアップ装置3と一体 的にトラックに追従するように位置制御されるようにな 成を示すプロック図である。図3において、光磁気ディ スク1は複数の渦巻状のトラックを有し、これらのトラ ックにはCLV(線速度一定)で情報が記録されていた り、あるいは、情報を基込むようになっている。スピン ドルモータ2は光磁気ディスク1を回転駆動するもので 信号の再生及び再生信号をトラックに対する位置制御に 供する機能と、読出しに際して高周波信号を重畳させる 機能とを有している。磁界変調ヘッド4は図1又は図2 褶動部をディスク面に所定の圧力で接触させるローディ っている。

るようにスピンドルモータ2の回転速度を制御するもの で、ピックアップ駆動回路32はピックアップ装置3及び に対する位置決め制御をするものである。また、電圧検 【0016】 一方、スピンドルモーク制御回路31は、後 出回路33は、その詳細を後述するように、磁界変調ヘッ ド4に装着された温度センサ若しくは温度検出コイルに 述する信号処理回路38の出力信号によりCLVを維持す 母界変調ヘッド4を一体的に駆動すると共に、トラック 発生した電圧を増幅して出力する。

対するメモリコントローラ39、変換回路41等の一速のデ 【0017】また、プリアンプ34はピックアップ装置3 中のセンサで検出されたレーザ戻り光に対応する信号を **方、コントローラ35の出力指令に対応してピックアップ** 装置3中のレーザ出力を制御する。コントローラ35はキ 一36からの指令に応じて、信号処理回路38、メモリ40に 入力してこれを増幅した後、信号処理回路38に加える一 ジタル信号処理系を用いて次の制御を行う。

●再生時に、プリアンプ34を介してRF信号が信号処理

回路38に入力されると、オーディオ信号に変換して出力 ②再生時及び書込み時に、スピンドルモータ2の速度を 検出してCLVとなる速度信号をスピンドルモータ制御

◎再生時及び告込み時に、レーザビームの正確なトレー スに必要なトラッキングエラー及びフォーカスエラーを 検出し、これらのエラーを補正する信号をピックアップ 駆動回路32に加える。 回路31に加える。

母告込み時に、オーディオ信号を量子化し、書込み回路 37を介して、磁界変調ヘッド4に加えると共に、レーザ ビームのパワーの制御信号を、プリアンプ34を介して、

⑤む込み開始時に、磁界変調ヘッド4の摺動部を光磁気 ディスク 1 に接触させるよりも前の時点と、摺動部を光 磁気ディスクに接触させてから所定の時間を経過した時 ピックアップ装置3に加える。

より僅かにディスク1の方向(図中下方向)に突出する

20

しめられる摺動部とが一体的に生成された磁界変調ヘッ

20

度制御方法を実施する光学式情報記録再生装置の全体構

9

示すものを用い、かつ、温度センサとしてサーミスタを 方法について説明する。磁界変調ヘッド4として図1に 用いた場合、湿度測定のために図4に示す回路が設けら れている。すなわち、コントローラ35のテスト信号TE STによって接点が閉じるスイッチSW1と、抵抗器R I、ダイオードD及び抵抗器R2 が高電位電源Vccと低 ー方、ダイオードDのアノードに抵抗器R3の一端が接 【0018】次に、本発明の光磁気ディスクの温度制御 電位電源としての接地点との間に直列接続されている。 統され、その他結が資算増幅器OPの反転入力端子

Pの非反転入力端子(+)に接続されている。また、演 (-) に接続され、さらに、ダイオードDのカソードに 抵抗器R4の一端が接続され、その他端が演算増幅器O 算増幅器○Pの反転入力端子と出力端子との間にフィー 非反転入力端子と接地点との間に抵抗器R6 が接続され ドバック用の抵抗器R5が接続され、演算増幅器OPの

ンサとしてダイオードを用いた場合には、図5に示すよ とスイッチSW1 が閉じられ、そのときの温度に応じた 電圧がサーミスタTHの両端に発生する。この電圧は演 されてレーザビームのパワーの制御に供される。温度セ うに、サーミスタTHの代わりにダイオードDを接続し **【0019】ここで、テスト信号TESTが印加される** 算増幅器OPを含む増幅回路で増幅された後、コントロ た回路構成となる。図5の他の構成は図4と同一である ーラ35のA/D変換器35Aによりデジタルデータに変換 ので説明を省略する。

ば、16分を経過した時刻11にて、それ自体の温度が を演算増幅器OPの出力に基づいて検出する。次に、光 磁気ディスク上に磁界変調ヘッドをローディングし、所 検出する。ここまでの温度検出はスピンドルモータ2の に基么に トコントローラ 35 が レーザ ビームの パワーを 制 御する場合の動作説明図である。周囲温度が0℃の環境 0℃の光磁気ディスクを挿入したとする。この光磁気デ イスクの温度は曲線Bに示すように0℃から25℃まで 急速に上昇する。光磁気ディスクへの昔込みは、これに 段界変調ヘッドをローディングして行うが、本実施例で はローディングする以前に25℃になっている周囲温度 定の時間、例えば、200msecを経過したときに光磁気 ディスクの温度を同じく演算増幅器OPの出力に基いて 【0020】図6は図4に示した資鉢増幅器OPの出力 に置かれた光学式情報記録再生装置に電源を投入したと き、装置内温度は曲線Aに示すように25℃まで上昇す るものとする。そこで、電源投入から10分以上、例え

回転を停止させた状態で行う。これら二つの検出値から することができる。つまり、装置全体の熱容量とディス 時間の変化に対応した光磁気ディスクの温度変化を予測 クの熱容量から決まる温度変化を予めROMに記憶さ

別することができる。従って、この予測値に対して予め 変化が分かる。そこで、時刻12で喜込みを開始する場 合、この時刻12 以降の光磁気ディスクの温度を全て予 **せ、光磁気ディスク上に磁界変調ヘッドをローディング** したときの温度検出値からその後の時間に対応した温度 設定した温度値に近付くようにレーザビームのパワーを

は、温度センサとしてのサーミスタTHが、OCにて抵 ど1 Vの電圧が発生するように抵抗器R1, R2 の抵抗 抗値が1. 1kので、25℃にて抵抗値が1kのであっ を閉じてこれに高電位電源Vocを接続したとき、ちょう 均幅器OPに加えられ、25℃では1. 0Vの電圧が額 算増幅器OPに加えられる。ここで、増幅率が1になる 値を決定する。従って、0℃では1. 1Vの塩圧が微算 たとする。抵抗値が1kOである状態でスイッチSW1 【0021】因みに、図4に示した回路構成にあって

ヘッドを光磁気ディスクにローディングしないとき、A / 口変換器からデジタルデータ「85」が出力され、光 たROMに登込まれたテーブルと対照することより、以 れらの処理を含めたむ込み時の処理手順は、図7のステ る。もし、A/D変換器35Aとして電源電圧が3Vで 8ビット出力のものを用いると、3Vの電圧でデジタル に対してデジタルデータ「94」が得られる。磁界変調 きにA/D変換器からデジタルデータ「94」が出力さ れたとすれば、この差がディスクと周囲の湿度差を表す これらの電圧がそのままA/D変換器35Aに加えられ データが「256」になることから、1Vの電圧に対し てはデジタルデータ「85」が得られ、1.1 Vの電圧 **磁気ディスク上に磁界変調ヘッドをローディングしたと** ことになる。また、これらのデジタルデータと、前述し 降の光磁気ディスクの温度を予測することができる。こ ように抵抗器R3, R5の抵抗値を決定したとすれば、

【0022】次に、図8は図2に示した磁界変調ヘッド あり、磁界発生部24に並設された磁界発生用のコイル26 高電位電源Vccと接地点との間に、PチャネルMOSF 列接続回路と、PMOSFETQ2 及びNMOSFET 24 の直列接続回路とが接続されている。PMOSFE FQ1 及びNMOSFETQ3 の接続点、つまり、ドレ インどうしの接続点に磁界発生用のコイル26の一端が接 続され、PMOSFETQ2 及びNMOSFETQ4の に対応する塩圧検出回路33及び書込み回路37の構成例で ETQI 及びNチャネルMOSFETQ3 (以下、Pチ ヤネルMOSFETを単にNMOSFETと称す)の直 ャネルMOSFETを単にPMOSFETと称し、Nチ 及び温度検出用コイル29が直列接続されている。一方、

ップ101~116の処理として示すことができる。

Q3 の各ゲートに接続されると共に、パッファBUを介 接続点、つまり、ドレインどうしの接続点に磁界発生用 のコイル26の他錨と、遛度検出用コイル29の一錨とが接 統されている。10 追展検出用コイル29の他緒にはNM OSFETQ5 のドレインが接続され、このNMOSF っており、このスイッチSW1の田力矯は、インバータ INを介して、PMOSFETQ1 及びNMOSFET ETQ5 のソースが接地点に接続されている。スイッチ SW1 は甚込みデータW. DATAと、接地電圧とをテ スト信号TESTによって切り替えて入力するようにな 端、及びNMOSFETQ4のゲートに接続されてい して、それぞれ切替えスイッチSW2の常閉側の入力

る。なお、切替えスイッチSW2の常開個の入力端は接 地点に接続され、その出力端はPMOSFETQ2 のゲ ートに接続されている。もう一つの切替えスイッチSW 3 の常閉側の入力端は接地され、常開側の入力端には高 電位電源Vccが接続され、その出力端はNMOSFET ル29の両端間に発生した低圧は、前述した資質増幅器の Q5 のゲートに接続されている。また、温度検出用コイ P及び抵抗器R3, R4, R5からなる増幅器で増幅され てA/D変換器35Aに加えられる。

際しては、テスト信号TESTによって切替えスイッチ SW2, SW3, SW4 は全て、図示の方向とは反対側 る。また、これらの回路は、書込みを開始する以前の温 **む込み中に磁界発生用のコイル26に正方向及び負方向に** 切り替わる電流を流すものである。ここで、温度検出に , NMOSFETQ3, Q5 はオン状態に、PMOSF ETQ1, NMOSFETQ4 はオフ状態になって、緑 界発生用のコイル26及び湿度検出用コイル29の両方に電 清が消れる。このとき、温度検出用コイル29の両籍に路 生した電圧を演算増幅器OPを中心とする増幅回路で増 P、抵抗器R3 , R4, R5が図3のជ圧検出回路33の構 成要素とすれば、これらの要素と磁界発生部24とを除い に切り替えられる。これによって、PMOSFETQ2 度検出中に温度検出用コイル29にテスト電圧を印加し、 たものが、図3の書込み回路37の構成要素になってい 【0023】この図8に示した回路中、演算増幅器の

る。これら温度の差から光磁気ディスク1の現在温度を ドルモータ2を停止させたまま、温度検出用コイル29に テスト低圧を印加して周囲温度を検出する。続いて、ス ピンドルモータ2を停止させたまま磁界変調ヘッド4を 【0024】いま、書込み指令が加えられた時、スピン 光磁気ディスク1上にローディングし、擂動部をディス ク面に接触させる。そして、周囲温度と光磁気ディスク 1の湿度との差で抵抗値が変化するまで、例えば、20 Omsecを経過するまで待つ。なお、磁界変調ヘッドの温 度が完全に光磁気ディスクの温度に一致するまで待つ必 要はない。その後、再度温度検出用コイル29にテスト電 圧を印加してその時の磁界変調ヘッドの温度を検出す

桜出し、 いれ に れっ トレー ザ アー オの パワー の 短 卸 か 沿

て0℃では湿度検出用コイル29の両端に1.8Vの電圧 イスクの温度が0℃で450、25℃で500になるも **【0025】因みに、湿度検出用コイル29としては、デ** のを用いる。そして、40mAの電流を流すことによっ を発生させる。この電圧を演算増幅器OPで1/2倍に

オフ状態にして磁界発生用のコイル26に正方向(図面の 状態に、PMOSFETQ2 及びNMOSFETQ3 を 状態に、PMOSFETQ2 及びNMOSFETQ3 を オン状態にして磁界発生用のコイル26に負方向(図面の 増幅すると0.9Vが得られる。そして、電源電圧が3 中は、切替えスイッチSW1 ,SW2 ,SW3 はいずれ き、PMOSFETQ1 及びNMOSFETQ4 をオン Vで8ピットのA/D変換器35Aに入力することによ ってデジタルデータ「75」が得られる。一方、昔込み W. DATAとして「H」レベルの信号が加えられたと W. DATAとして「L」レベルの信号が加えられたと き、PMOSFETQ1及びNMOSFETQ4 をオフ も図示した状態に保持される。そして、

なみデータ 右から左方向)の電流を流し、反対に、昔込みデータ

用のコイル26そのものを温度センサとして、ディスクの タータップ型にしたが、これらのコイルは互いに切り職 てもよい。ところで、上記実施例はそれぞれ磁界発生用 のコイル26の他に温度センサ又は湿度検出用のコイルを 設けた磁界変調ヘッドを対象にしたが、褶動部がディス ク面に接触せしめられることを前提にすれば、磁界発生 して、温度検出用コイル29には専用の測定回路を付加し [0026] なお、この実施例では、磁界発生用のコイ ル26及び温度検出用コイル29を接続して、いわば、セン 温度を検出することができる。

 左から右方向) の領流を消す。

20

【0027】図9は磁界発生用のコイル26を温度センサ

されている。PMOSFETQ1及びNMOSFETQ 位電源Vccにソースが接続されたPMOSFETQ1の Q4 のソースがスイッチSW5 の入力端に接続されてい る。スイッチSW5の常財匈田力増子は接地され、常開 側出力端子は定電流額Jを介して低低位電源Vssに接続 としても利用する場合の構成例である。ここでは、高電 このNMOSFETQ3 のソースがスイッチSW5 の入 が接続された PMO SFET Q2 のドレインにNMO S FETQ4のドレインが接続され、このNMOSFET DATAが加えらけれ、常開闽入力端子は接地され、こ 力端に接続されている。また、高電位電源Vccにソース 3 の接続点と、PMOSFETQ2 及びNMOSFET Q4 の接続点との間に、抵抗器R1 、磁界発生用のコイ スイッチSW3 は紙因囱の入力猶予に払込みデータW. ドレインにNMOSFETQ3 のドレインが被結され、 ル26及び抵抗器R2 の直列接続回路が接続されている。

40

20

の切替えスイッチSW3の出力結は、インバータINを

20

介して、PMOSFETQ1及びNMOSFETQ3の **, R4 , R5, R6 からなる増幅器で増幅してA/D変** 接続されている。また、磁界発生用のコイル26の両端に 各ゲートに接続されると共に、パッファBUを介して、 PMOSFETQ2&UNMOSFETQ4 OF-FE 発生した電圧を、前述の演算増幅器OP及び抵抗器R3 **険器に加えるようになっている。**

て、図示の方向とは反対側に切替えられる。これによっ 周囲温度を検出する。この場合、磁界発生用のコイル26 【0028】ここで、湿度検出に際しては、テスト信号 て、PMOSFETQ2,NMOSFETQ3 はオン状 版に、PMOSFETQ1, NMOSFETQ4 はオフ 状態になって、磁界発生用のコイル26に電流が流れると のとき、磁界発生用のコイル26の両端に発生した億圧が 演算増幅器OPを中心とする増幅回路で増幅される。そ こで、む込み指令が加えられた時、スピンドルモータ2 を停止させたまま、磁界変調ヘッドをアンローディング の状態にして温度検出用コイル29にテスト電流を流して は温度が25℃において5.00、0℃において4.5 5. 0 G の温度検出用コイル29に2 0 0 m A の電流を流 すことによって 1.0 Vの電圧が発生する。この電圧を る。また、電源電圧が3Vで8ビットのA/D変換器に 入力することによってデジタルデータ「85」が得られ との関係を示すテーブルを用いてその時点の温度、すな 共に、定電流源」によって電流が一定に制御される。こ る。ここで、テスト電流を遮断すると共に、予めROM 又はEEPROMに書込んであるデジタルデータと湿度 TESTによって切替えスイッチSW3, SW5 は全 Ωになるものを用いる。したがって、25℃において **演算増幅器OPで1倍に増幅すると1.0Vが得られ** わち、周囲温度を求める。

ングし、摺動部をディスク面に接触させる。そして、周 するまで、例えば、200msecを経過するまで待つ。な ヘッドの温度を検出する。その時、0℃であったとすれ 【0029】続いて、スピンドルモータ2を停止させた **周温度と光磁気ディスク1の温度との差で抵抗値が変化** お、磁界変調ヘッドの温度が完全に光磁気ディスクの温 度に一致するまで待つ必要はない。その後、再度温度検 出用コイル29にテスト電圧を印加してその時の磁気変調 9 V が得られる。この電圧をA/D変換器に入力するこ こで、テスト電流を遮断すると共に、前記のデジタルデ ータ「85」との差「9」より予めROMXはEEPR OMに書込んであるデジタルデータと温度との関係を示 まま磁界変調ヘッド4を光磁気ディスク1上にローディ とによってデジタルデータ「7 6」が得られる。 またこ る。この電圧を演算増幅器OPで1倍に増幅するとの. ば、磁界発生用のコイル26の両端に0、9 V が発生す すテーブルを用いてその時点の湿度を求める。

20 【0030】このように、光磁気ディスク1に磁界変調 ヘッド4をローディングする前と、ローディングしてか

ディスク温度を予測する。そして、ROMに書込んでお を制御する。もちろん、昔込みの直前に磁界変調ヘッド ら一定時間を経過した時点の温度との差が周囲温度とデ クの湿度は周囲湿度に近付こうとするから、装置全体の 熱容量及びディスクの熱容量に基づいて予めROMに設 **定した遺皮兼近線のテーブルと、光環気ディスク 1 に碌** るタイマの値とにより、書込み指示のあった時点の記録 いた予測温度と電圧との関係に従ってレーザビーム出力 4を光磁気ディスク1にローディングするので、この時 **界変調ヘッド4をローディングしてからの時間を計測す** イスクとの温度差である。時間の経過に応じて、ディス 点で温度を測定しても構わない。

[0031] その後、スピンドルモータ2を起動し、レ ラッキングエラーを検知し、これらのエラーを容に近付 OC (User Table Of Contents) に移動し、必要な情報 **一ザピームのトラックに対するフォーカスエラーと、ト** けるようにピックアップ装置3を制御すると共に、CL Vにて回転駆動することによりピックアップ部をディス 1 に磁界変調ヘッド4をローディングしてからの時間を を読出し、そこで書込みを行う。なお、光磁気ディスク 計時するタイマは、光磁気ディスク1の湿度が周囲温度 クの最内周付近TOC (Table Of Contents) 又はUT と実質的に一致したと判断した段階でクリアされる。

オフ状態にして磁界発生用のコイル26に正方向(図面の 【0032】杏込み中は、切替えスイッチSW3, SW き、PMOSFETQ1 及びNMOSFETQ4 をオン 状態に、PMOSFETQ2 及びNMOSFETQ3 を W. DATAとして「H」レベルの信号が加えられたと W. DATAとして「L」レベルの信号が加えられたと オン状態にして磁界発生用のコイル26に負方向(図面の 5 はいずれも図示した状態に保持される。 昔込みデータ 状態に、PMOSFETQ2及びNMOSFETQ3を き、PMOSFETQ1 及びNMOSFETQ4をオフ 右から左方向)の電流を流し、反対に、費込みデータ 左から右方向)の縄流を減す。

は、高電位電源Vccにソースが接続されたPMOSFE インが接続され、このNMOSFETQ4 のソースが接 れ、この切替えスイッチSW3の出力端は、インパータ いる。また、高電位電源Vccにソースが接続されたPM OSFETQ2 OFV/VENMOSFETQ4 OFV Q3 の接続点と、PMOSFETQ2 及びNMOSFE TQ4 の接続点との間に、抵抗器R1、磁界発生用のコ る。スイッチSW3 は常閉側の入力端子に書込みデータ 【0033】図10は磁界発生用のコイル26を温度セン 続され、このNMOSFETQ3 のソースが接地されて 地されている。PMOSFETQI 及びNMOSFET サとしても利用するもう一つの構成例である。ここで TQ1のドレインにNMOSFETQ3 のドレインが扱 イル26及び抵抗器R2 の直列接続回路が接続されてい W. DATAが加えらけれ、常開側入力端子は接地さ 40

8

I Nを介して、PMOSFETQ1 及びNMOSFET Q3 の各ゲートに接続されると共に、バッファBUを介 LT, PMOSFETQ2 AUNMOSFETQ4 04 ートに接続されている。また、磁界発生用のコイル26の 両端に発生した低圧を、前述の演算増幅器OP及び抵抗 器R3, R4, R5, R6からなる増幅器で増幅してA / D変換器に加えるようになっている。

は反対側に切替えられる。これによって、PMOSFE ETQ1, NMOSFETQ4 はオフ状態になって、斑 【0034】ここで、湿度検出に際しては、テスト信号 TESTによって切替えスイッチSW3 は図示の方向と TQ2, NMOSFETQ3 はオン状態に、PMOSF 界発生用のコイル26にテスト電圧が印加される。このと き、磁界発生用のコイル26の両端に発生した電圧が演算 増幅器OPを中心とする増幅回路で増幅される。

温度との差で抵抗値が変化するまで、例えば、200ms データ「76」が得られる。またここで、テスト電流を **気ディスク1上にローディングし、褶動部をディスク面** 60を経過するまで待つ。 なお、磁界変調ヘッドの温度が 両端に1.8Vの電圧が発生する。この電圧を演算増幅 【0035】いま、書込み指令が加えられた時、スピン ドルモータ 2 を停止させたまま磁界変調ヘッド 4 を光磁 に接触させる。そして、周囲温度と光磁気ディスク1の 完全に光磁気ディスクの温度に一致するまで待つ必要は ない。その後、再度温度検出用コイル29にテスト電圧を 印加してその時の磁気変調ヘッドの温度を検出する。そ の時、0℃において4.50であったとすれば、400 mAの塩流を流すことによって磁界発生用のコイル26の の電圧をA/D変換器に入力することによってデジタル 遮断すると共に、予めROM又はEEPROMに昔込ん であるデジタルデータと温度の絶対値との関係を示すテ **ーブルを用いてその時点の温度を求める。次に、この温** 取に対応してソーザアームのパワーを設定し、所定の故 器OPで1/2倍に増幅すると0.9Vが得られる。こ

【図面の簡単な説明】

まうので、コイルが発热しないように短時間にて測定を 行う必要性がある。なお、上述の実施例のうち、湿度検 ESTによって切替えるだけで済むが、沓込み時にに実 は、抵抗値の変化を利用して光磁気ディスクの温度を検 出したが、磁界発生部の湿度が変化すると、コアを構成 するフェライトの透磁率も変化してインダクタンスも変 化するため、抵抗値及びインダクタンスを含むインピー ダンスの変化を利用して光磁気ディスクの温度を検出す 際に供している大きめの電流(400mA)が流れてし 切替えスイッチSW3を追加して、これをテスト信号T 【0036】図10に示した回路構成を採用した場合、 出用コイル29又は磁界発生用のコイル26を用いるもの

【発明の効果】以上の説明によって明らかなように、本 [0037]

特開平7-182721

発明の光磁気ディスクの磁界変調ヘッドによれば、光磁 とを利用してディスクの温度を正確に検出することがで きるため、ディスクの温度を正確にキュリー点に到達さ **気ディスクのディスク国に諮勘部が接触せしめられるこ** せることができる。

定の記録温度との偏差を零に近付けるように加熱手段の レーザビームのパワーを制御するので、ディスクの湿度 を正確にキュリー点に到達させることができるという効 磁気ディスクの温度制御方法によれば、レーザビームの パワーを制御するに当たり、磁界発生用コイル又はこれ 【0038】また、本発明の光磁気ディスクの温度制御 度変化を予測し、少なくとも記録を開始した初期は、所 果が得られる。さらにまた、本発明に係るもう一つの光 に付随的に巻数するだけで済む温度検出用コイルにテス 方法によれば、督動部を光磁気ディスクに接触させるよ りも前の時点と、摺動部を光磁気ディスクに接触させて し、その検出値に基づき経過時間に対応した記録層の温 ト電流を流すという特有な方法で光磁気ディスクの温度 を検出しているので、ディスクの温度を正確にキュリー 温度検出のための専用の素子、例えば、サーミスタやダ 磁界変調ヘッドの構成の簡易化および装置コストの低廉 イオード箏を装着する必要がなくなり、これによって、 から所定の時間を経過した時点とでそれぞれ湿度検出 点に到達させることができるという効果が得られる他、 化が達成できるという効果も得られている。 20

【図1】本発明に係る光磁気デイスクの磁界変調ヘッド 【図2】本発明に係る光磁気デイスクの磁界変調ヘッド の第1 実施例の構成を示す断面図である。

【図3】本発明に係る光磁気テイスクの温度制御方法を 実施するための情報記録再生装置の構成例を示すプロッ の第2実施例の構成を示す断面図である。 ク図である。

【図4】図3に示した情報記録再生装置の主要素の詳細 な構成を示す回路図である。

【図5】図3に示した情報記録再生装置の主要素の詳細 な構成を示す回路図である。

【図6】本発明に係る光磁気ディスクの湿度制御方法を 説明するために、時間と温度との関係を示した線図であ 40 [図7] 本発明に係る光磁気ディスクの温度制御方法を 説明するために、図3に示した情報記録再生装置の処理 手順を示すフローチャートである。

[図8] 本発明に係る光磁気ディスクの湿度制御方法を 実施する装置の他の構成例を示す回路図である。

【図9】本発明に係る光磁気ディスクの温度制御方法を 実施する装置のもう一つ他の構成例を示す回路図であ 【図10】本発明に係る光磁気ディスクの温度制御方法 を実施する装置のさらに他の構成例を示す回路図であ

20

特開平7-182721

91

る。 【図11】従来の光磁気デイスクの磁界変調ヘッドの構 成例を示した断面図及び側面図である。

26 磁界発生用コイル

2 5

27 温度センサ

[符号の説明]

1 光磁気ティスク

3 ピックアップ装置

4 磁界変調ヘッド

23 褶動部

2.4 磁界発生部

24A 磁界発生部のフレーム

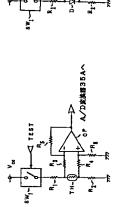
<u>⊠</u>

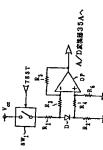
31 スピンドルモータ制御回路 アックアップ駆動回路 29 温度検出用コイル 33 電圧検出回路35 コントローラ37 書込み回路 電圧検出回路 コントローラ 3 2 91

[図3]

[図2]

5. 有自国路 APC LEGRELI ブリアンプ 37 大公司 第25





-6-

[図2]

[図4]

